

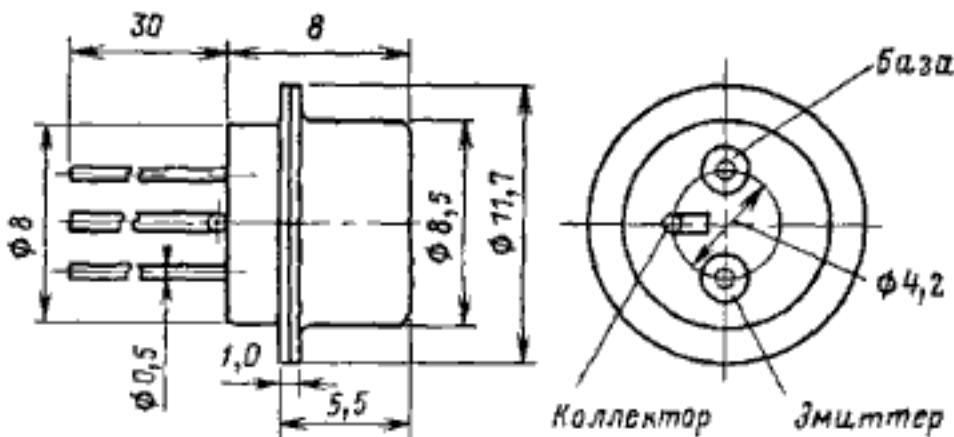
# П307, П307В, П308, П309

Транзисторы кремниевые планарные *n-p-n* переключательные низкочастотные маломощные.

Предназначены для применения в схемах переключения и преобразователей постоянного напряжения.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.



### Электрические параметры

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 4$ мА не менее . . . . .	20 МГц
Входное сопротивление при $U_{KB} = 20$ В, $I_3 = 10$ мА не более . . . . .	70 Ом
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $I_3 = 10$ мА, $U_{KB} = 20$ В	
П307, П309 . . . . .	20–60
П307В. . . . .	50–150
П308 . . . . .	30–90
Сопротивление насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 15$ мА, $I_B = 3$ мА не более	
при $T = 298$ К	
П307 . . . . .	100 Ом
П307В, П308, П309 . . . . .	130 Ом
при $T = 398$ К . . . . .	240 Ом
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB\max}$ не более . . . . .	3 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{K3} = U_{K3\max}$ , $R_{EB} \leq 10$ кОм не более	
при $T = 298$ К . . . . .	20 мкА
при $T = 398$ К . . . . .	200 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 3$ В не более	
при $T = 298$ К . . . . .	5 мкА
при $T = 398$ К . . . . .	15 мкА

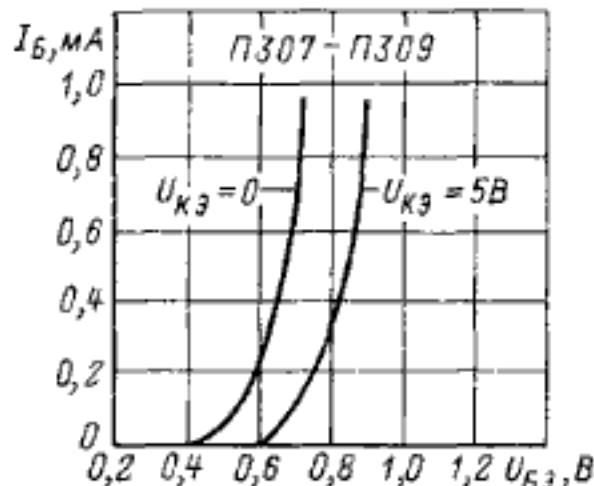
## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при  $R_{\text{ЭБ}} \ll 10 \text{ кОм}$

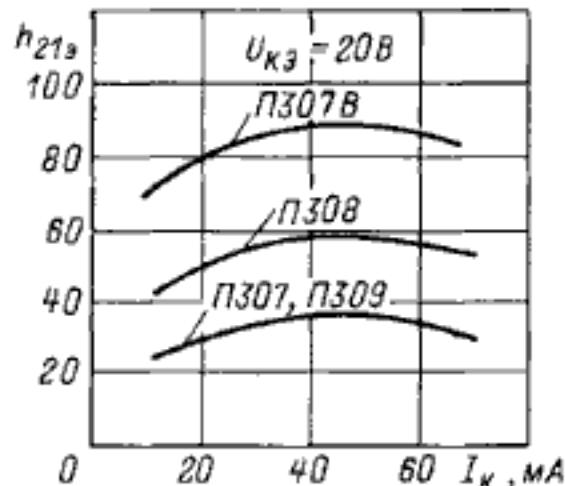
П307, П307В	...	80	В
П308, П309	...	120	В
Постоянное напряжение эмиттер-база	...	3	В
Постоянный ток коллектора	...	30	мА
Импульсный ток коллектора при $t_i \leq 1$ мкс, $Q \geq 10$	...	120	мА
Постоянная рассеиваемая мощность			
при $T \leq 293$ К	...	250	мВт
при $T = 373$ К	...	150	мВт

при $T = 393$ К . . . . .	100 мВт
при $T = 398$ К . . . . .	87,5 мВт
Температура перехода . . . . .	423 К
Общее тепловое сопротивление	
при $T \leq 373$ К . . . . .	0,8 К/мВт
при $T \geq 373$ К . . . . .	0,4 К/мВт
Температура окружающей среды . . . . .	От 213 до 398 К

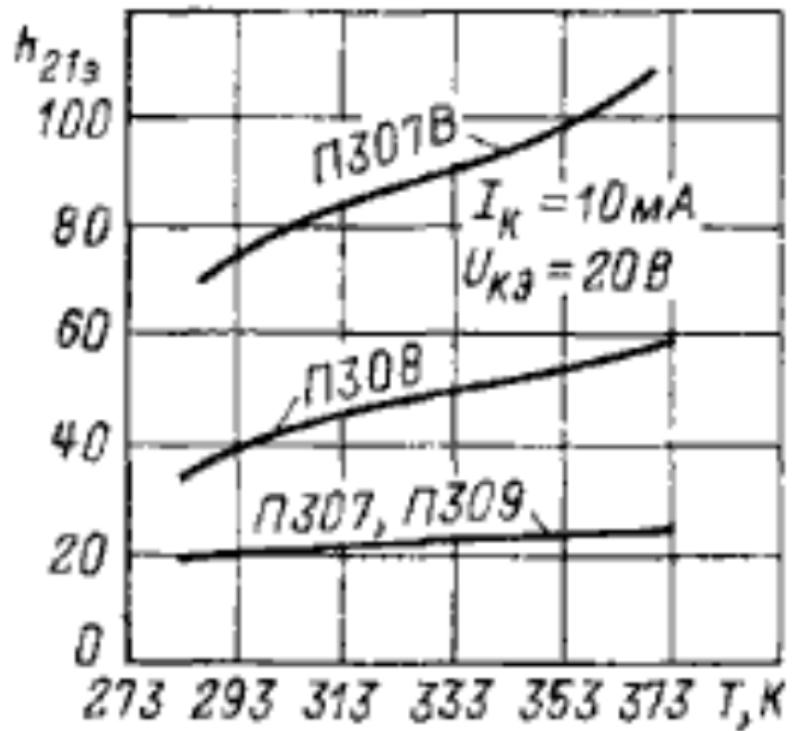
Примечание Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. Пайку производить паяльником при  $T \leq 533$  К в течение не более 10 с. Необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса, при этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность вывода между изгибом и стеклянным изолятором, чтобы не произошло нарушения спая выводов со стеклянным изолятором, ведущего к потере герметичности транзистора.



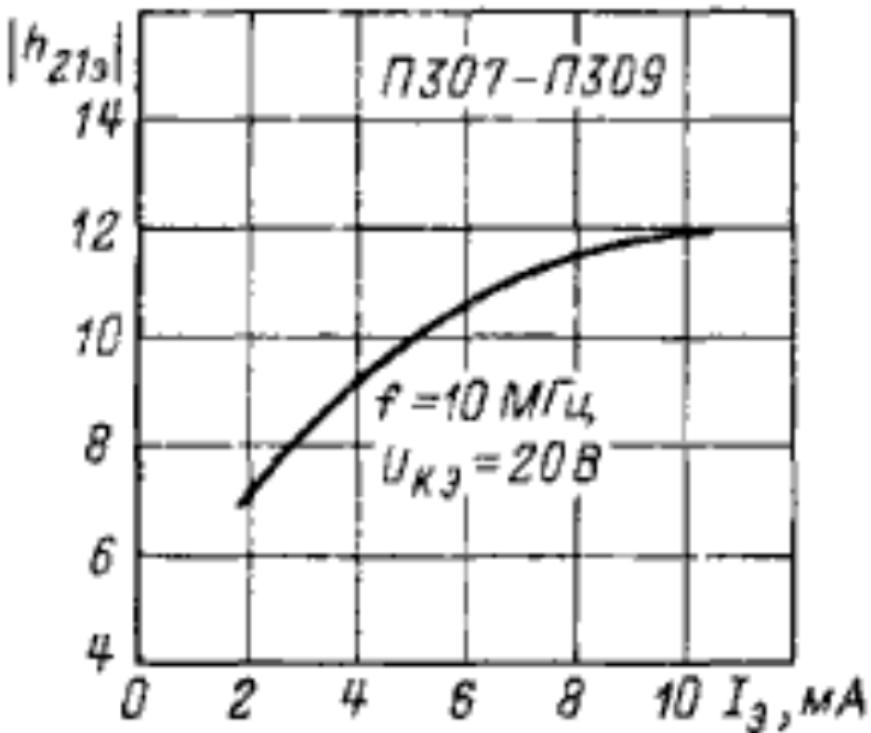
Входные характеристики



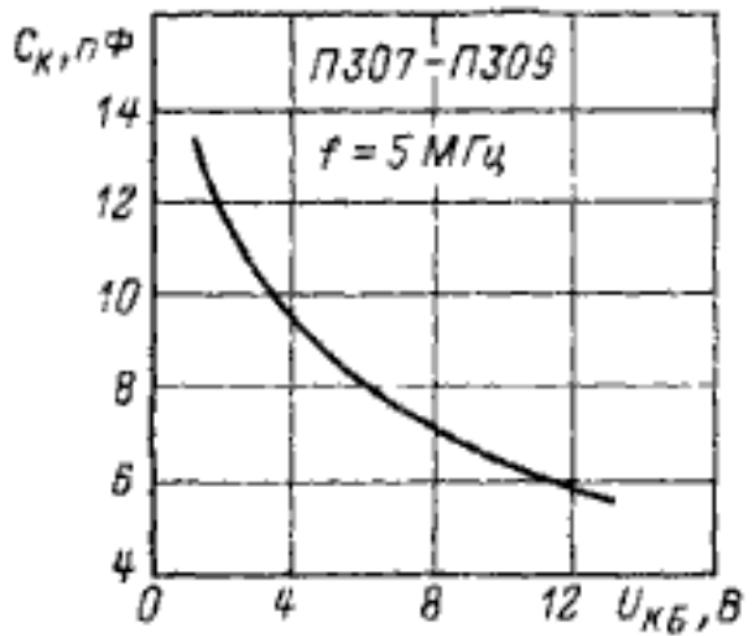
Зависимость коэффициента передачи тока от тока коллектора



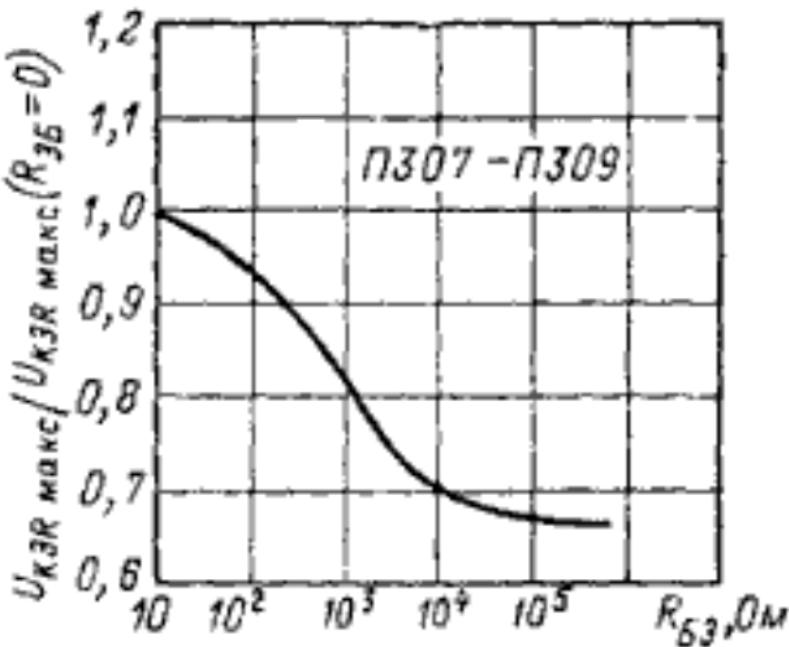
Зависимость коэффициента передачи тока от температуры



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



Зависимость относительного максимально допустимого на пряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер